中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號: 383908

[44]中華民國 89年 (2000) 03月 01日

新型

[51] Int.Cl ⁰⁶; H01L23/34

第 (10 857) 號初審(訴願)引証附件一

[54]名 稱:增加微電子裝置散熱之結構

[21]申請案號: 087215690

[22]中請日期:中華民國 87年 (1998) 09月22日

[72]創作人:

李基銘陳國明

台北市金華街一八一之七號四樓 新竹縣北埔鄉大林村五鄰十六之一號

[71]申請人:

鑫成科技股份有限公司 新竹縣竹東鎮中興路二段五四一巷十一號

[74]代理人: 黃重智 先生

1

2

[57]申請專利範圍:

- 1 一種增加微電子裝置散熱之結構,其係 在一電路板之二面分別形成二具良導熱 性之區域,該二具良導熱性之區域之間 並以具良導熱性之路徑連接,其中,第 一具良導熱性之區域供連接微電子裝 置,俾將該連接之微電子裝置所傳來之 熱經由該具良導熱性之路徑傳導至第二 具良導熱性之區域,因而幫助該連接之 微電子裝置散熱者。
- 2.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述具良導熱 性之路徑係鍍通孔者。
- 3.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述具良導熱 性之路徑係導熱柱者。
- 4.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,<u>所述二具良導</u> 熱性之區域及具良導熱性之路徑亦具良 導電性者。
- 5.如申請專利範圍第4項所述增加微電子

- 裝置散熱之結構,其中,<u>所述具良導熱性之路徑更接地者</u>。
- 6.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述第二具良 導熱性之區域係被防焊層覆蓋者。
- 7.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述第二具良 導熱性之區域係完全裸露者。
- 8.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述第二具良 導熱性之區域係部份裸露者。
- 9.如申請專利範圍第1項所述增加微電子 裝置散熱之結構,其中,所述第二具良 導熱性之區域更連接有散熱器者。
- 15. 10.如申請專利範圍第 9 項所述增加微電子裝置散熱之結構,其中,所述散熱器形成有散熱鰭者。
 - 11.如申請專利範圍第10項所述增加微電子裝置散熱之結構,其中,所述散熱館 更連接有風扇者。

20.

10.

圓式簡單說明:

第一圖係習知技藝中,於一積體電路裝置外部加裝散熱器/風扇之示意圖。

第二圖係習知技藝中,一球柵陣列 封裝之積體電路裝置安裝在電路板上的示 意圖。

第三圖係本創作一實施例的示意 圖,其具有背側式的散熱結構。

第四圖及第五圖係本創作之電路板 背面二實施例的示意圖。 第六圆係第五圆所示實施例再外加

散熱器/風扇之示意圖,此結構能夠更進 一步地加強散熱效果。

第七圖係本創作另一實施例的示意 5. 圖,其中,具良導熱性之路徑係金屬導熱 柱者。

> 第八圖係說明利用本創作配合習知 外加散熱器/風扇增加微電子裝置散熱之 示意圖。

10.









